




	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB160N04S4H1ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 160A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB160N04S4H1ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB160N04S4H1ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 160A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 110µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10920pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	137nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	160A (Tc)

IPB160N04S4H1ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB160N04S4H1ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB160N04S4H1ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB160N04S4H1ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB160N04S4LH1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB160N04S4-02D INFINEON IPB160N04S4-02D INFINEON</p>	 <p>IPB160N08S403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB16CN10N INFINEON IPB16CN10N INFINEON</p>
 <p>IPB160N04S4L-H1 INFINEON IPB160N04S4L-H1 INFINEON</p>	 <p>IPB16CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 53A TO263-3</p>	 <p>IPB160N04S3H2ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB160N04S2L03ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB160N04S4H1ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB160N04S4H1ATMA1 Datenblatt	IPB160N04S4H1ATMA1-Datenblätter	IPB160N04S4H1ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB160N04S4H1ATMA1
IPB160N04S4H1ATMA1 Electronic	IPB160N04S4H1ATMA1-Komponenten	IPB160N04S4H1ATMA1-Verteiler	IPB160N04S4H1ATMA1-Bild	IPB160N04S4H1ATMA1-Teil
IPB160N04S4H1ATMA1 Preis	IPB160N04S4H1ATMA1 Hersteller	IPB160N04S4H1ATMA1 Bild	IPB160N04S4H1ATMA1 Aktie	IPB160N04S4H1ATMA1 Inventar
IPB160N04S4H1ATMA1 Neu	IPB160N04S4H1ATMA1 Original	IPB160N04S4H1ATMA1 garantiert	IPB160N04S4H1ATMA1 RFQ	IPB160N04S4H1ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited